



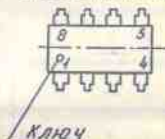
Микросхемы типов КР504НТ1,  
КР504НТ2

### Э Т И К Е Т К А

Кремниевые интегральные микросхемы КР504НТ1А, КР504НТ1Б, КР504НТ1В, КР504НТ2А, КР504НТ2Б, КР504НТ2В представляют собой однокристалльные согласованные пары полевых транзисторов, предназначенные для применения в серийной аппаратуре.

Климатическое исполнение УХЛ: 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1; 5.1.

Схема расположения выводов



масса не более 1 г.

Таблица назначения выводов

Вывод	Назначение	Вывод	Назначение
1	Сток VТ1	5	Сток VТ2
2	Исток VТ1	6	Затвор VТ2
4	Исток VТ2	8	Затвор VТ1

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ  $t = 25^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Формы											
		КР504НТ1А		КР504НТ1Б		КР504НТ1В		КР504НТ2А		КР504НТ2Б		КР504НТ2В	
		не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее
Начальный ток стока, мА (при $U_{\text{СН}} = -10\text{ В}$ , $U_{\text{ЭН}} = 0$ )	$I_{\text{С,нач}}$	0,1	0,7	0,4	1,5	0,7	2	0,1	0,7	0,4	1,5	0,7	2
Напряжение отсечки, В (при $I_{\text{С}} = 10\text{ мкА}$ , $U_{\text{СН}} = -5\text{ В}$ )	$U_{\text{ЭН,отс}}$	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5
Кривизна характеристики, мА/В, (при $U_{\text{СН}} = -10\text{ В}$ , $f = 270\text{ Гц}$ , $U_{\text{ЭН}} = 0$ )	$S$	0,3	-	0,5	-	0,7	-	0,3	-	0,5	-	0,7	-
Ток утечки затвора, мА (при $U_{\text{ЭН}} = 5\text{ В}$ )	$I_{\text{в,ут}}$	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2

Продолжение

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Формы											
		КР504НТ1А		КР504НТ1Б		КР504НТ1В		КР504НТ2А		КР504НТ2Б		КР504НТ2В	
		не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее
Разность напряжений затвор-исток, мВ (при $U_{\text{ЭС}} = -5\text{ В}$ , $I_{\text{С}} = 100\text{ мкА}$ )	$ U_{\text{ЭН1}} - U_{\text{ЭН2}} $	-	30	-	30	-	30	-	-	-	-	-	-
Отношение кривизн характеристик (при $U_{\text{СН}} = -10\text{ В}$ , $U_{\text{ЭН}} = 0$ , $f = 270\text{ Гц}$ )	$\frac{S_1}{S_2}$	-	-	-	-	-	-	0,85	-	0,85	-	0,85	-
Отношение начальных токов стока (при $U_{\text{СН}} = -10\text{ В}$ , $U_{\text{ЭН}} = 0$ )	$\frac{I_{\text{С,нач 1}}}{I_{\text{С,нач 2}}}$	-	-	-	-	-	-	0,85	-	0,85	-	0,85	-

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 ШТ. МИКРОСХЕМ

0.2359г-3,999.9

Золото \_\_\_\_\_ г

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы соответствуют техническим условиям

СКО.348.654 ТУ.

Приняты по извещению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ дата

Штамп ОИК

